

## 半导体所“低热阻高光效半导体照明关键技术”通过鉴定



鉴定会现场

2014年1月18日，由中国科学院科技促进发展局主持召开的“低热阻高光效半导体照明关键技术”科技成果鉴定会在中科院半导体研究所举行。

成果鉴定会上，由清华大学周炳琨、北京大学甘子钊、中科院微电子研究所吴德馨及南京大学郑有料等多位院士和行业内知名专家组成的鉴定委员会听取了半导体照明研发中心研究员李晋闽的技术总结报告、测试报告、技术查新报告及用户使用报告，并审查了相关材料，最终对该项成果形成了鉴定意见。该技术重点解决了高端功率型LED发光效率低和散热性能差两大技术瓶颈，通过技术辐射有力提高了国内高端功率型LED的产业化水平。

该项成果技术创新特色突出，具有重要的科学意义和实用价值，实现了低热阻高光效半导体照明核心器件，与国内外同类技术相比，总体上达到国际领先水平。同时该成果已经成功转移到相关企业，取得重要的社会和经济效益。其中复合光学膜技术已被行业广泛采用，成为主流关键工艺技术，有力地促进了高端LED芯片的国产化进度。最终，鉴定委员会一致同意“低热阻高光效半导体照明关键技术”通过成果鉴定。

此次鉴定会的成功召开，不仅展示了照明中心在半导体照明领域科研方面的新成果，提升了中心在相关领域的影响力，也为今后的发展奠定了坚实基础，为企业的发展提供了有力的保障。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/57128.html>